

12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22) Date de dépôt : 19.01.07.

30) Priorité :

43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 25.07.08 Bulletin 08/30.

56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

71) Demandeur(s) : STMICROELECTRONICS (CROLLES) 2 SAS Société par actions simplifiée — FR.

72) Inventeur(s) : CORONEL PHILIPPE et FENOUILLET BERANGER CLAIRE.

73) Titulaire(s) :

74) Mandataire(s) : BREVALEX.

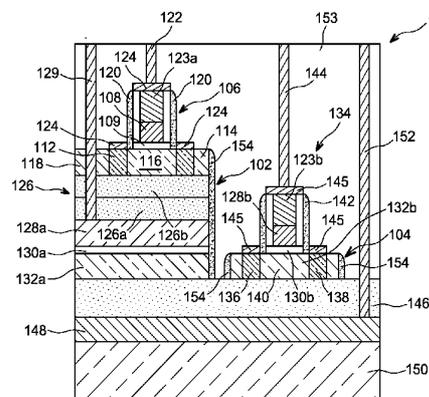
54) DISPOSITIF A MOSFET SUR SOI.

57) L'invention concerne un dispositif (1) à MOSFET (106, 134) sur SOI, comprenant:

- une région supérieure (102) comportant au moins un premier dispositif semi-conducteur (106) de type MOSFET disposé sur une première couche de semi-conducteur (118) empilée sur une première couche isolante (126), une première portion (128a) d'une première couche métallique et une première portion (132a) d'une seconde couche de semi-conducteur;

- une région inférieure (104) comportant au moins un second dispositif semi-conducteur (134) de type MOSFET disposé sur une seconde portion (132b) de la seconde couche de semi-conducteur, une grille (128b) du second dispositif semi-conducteur (134) étant formée par une seconde portion (128b) de la première couche métallique.

La seconde couche de semi-conducteur (132) est disposée sur une seconde couche isolante (146) empilée sur une seconde couche métallique (148).



FR 2 911 721 - A1



**DISPOSITIF A MOSFET SUR SOI****DESCRIPTION****DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR**

5 L'invention concerne la réalisation d'un  
dispositif à MOSFET (« Metal-Oxide Semiconductor Field-  
Effect Transistor » en anglais, ou transistor à effet  
de champ de semi-conducteur d'oxyde de métal) sur SOI  
(« Silicon On Insulator » en anglais, ou silicium sur  
10 isolant).

Afin de satisfaire les prévisions de l'ITRS  
(« International Technology Roadmap for  
Semiconductors ») pour les générations futures de  
transistors, il est nécessaire de faire évoluer  
15 l'architecture des MOSFET.

L'ITRS indique que l'augmentation de la  
mobilité des porteurs dans le canal des transistors  
devient nécessaire pour maintenir l'accroissement des  
performances pour les générations de transistors dont  
20 les longueurs de grille sont inférieures à 100 nm.

Pour cela, il est par exemple possible  
d'utiliser des substrats à base de silicium contraint.  
Il est également possible d'utiliser des modules, ou  
couches internes aux dispositifs, qui, de par leur  
25 contrainte intrinsèque, viennent mettre en tension ou  
en compression le transistor.

Les documents « High Performance CMOS  
Fabricated on Hybrid Substrate With Different Crystal  
Orientations » de M. Yang et al, Electron Devices  
30 Meeting 2003 Technical Digest. IEEE International, du 8

au 10 décembre 2003, pages 18.7.1 à 18.7.4, et « On the Integration of CMOS with Hybrid Crystal Orientations », de M. Yang et al, 2004 Symposium on VLSI Technology, Digest of Technical Papers, du 15 au 17 juin 2004, pages 160 à 161, décrivent un dispositif réalisé sur un substrat de silicium à orientations cristallines hybrides, c'est-à-dire comportant un transistor NMOS réalisé sur une partie du substrat dont l'orientation cristalline est (100) et un transistor PMOS sur une partie du substrat dont l'orientation cristalline est (110). La partie du substrat sur laquelle est réalisé un des deux transistors est de type SOI, l'autre partie du substrat sur laquelle est réalisé l'autre des deux transistors étant de type bulk. Ce type de structure permet également d'augmenter la mobilité des porteurs dans le canal des transistors. Ce type de dispositif a notamment pour inconvénient que les deux transistors ont des propriétés et des fonctionnements très différents. De plus, l'avantage d'un substrat SOI par rapport à un substrat de type bulk ne peut être obtenu que pour l'un des deux transistors. Enfin, il n'est pas possible d'avoir une commande arrière, ou « ground plane », pour le transistor se trouvant sur la partie SOI car celle-ci affecterait le comportement du transistor se trouvant sur la partie bulk du substrat.

Le document « Back-Gated CMOS on SOIAS for dynamic threshold voltage control » de I.Y. Yang et al., IEEE Trans on Elec Devices, vol 44, n°5, Mai 1997, pages 822 à 831, décrit un dispositif CMOS sur SOI de type double grille avec connexion des grilles, ou commandes, arrières. L'épaisseur de l'oxyde enterré est

supérieure à 65 nm et celle du silicium est supérieure à 40 nm. Les commandes arrières sont réalisées par implantation, ce qui implique un dopage des canaux du dispositif CMOS, venant perturber le fonctionnement de ces canaux (ajustement des tensions de seuil complexifié). Les charges placées dans le diélectrique suite à l'implantation vont également modifier les effets de couplage électrostatique, ce qui aura un impact sur les effets de canal court de ce dispositif CMOS. De plus, les zones dopées des commandes arrières s'étendent uniquement sous les zones actives des transistors, rendant la connexion de ces commandes arrières complexe.

Le document « 65nm High Performance SRAM Technology with  $25F^2$ ,  $0.16\mu m^2$   $S^3$  (Stacked Single-crystal Si) SRAM Cell, and Stacked Peripheral SSTFT for Ultra High Density and High Speed Applications » de Hoon Lim et al., Proceedings of ESSDERC, 2005, pages 549 à 552, décrit une architecture comportant des transistors MOS empilés les uns sur les autres sur trois niveaux. Ce type d'architecture permet de gagner en densité d'intégration des transistors (moins de place occupée), mais ce gain implique une plus grande complexité du procédé pour réaliser une telle structure (multiplication des étapes de photolithographie nécessaires à la réalisation des grilles des transistors). De plus, les transistors empilés du dispositif SOI ne sont pas optimisés car leur couche d'oxyde enterré est épaisse et il n'est pas possible d'améliorer les performances par une commande arrière. L'orientation cristalline optimale pour ce

dispositif n'est également réalisable que par collage. Enfin, le silicium polycristallin déposé doit être recristallisé, impliquant un long budget thermique à basse température ou plusieurs étapes de collage, augmentant le coût de réalisation de ce dispositif.

### **EXPOSÉ DE L'INVENTION**

Un but de la présente invention est de proposer un dispositif à MOSFET permettant d'obtenir de bonnes performances en terme de flexibilité pour optimiser les performances des NMOS et PMOS indépendamment l'un de l'autre, en fonctionnement dynamique du circuit, conservant un bon contrôle électrostatique, c'est-à-dire limitant les effets de canal court sur la tension de seuil, permettant une commande arrière de canal pour pouvoir réaliser de multiples  $V_{th}$ , et pouvant intégrer des dispositifs semi-conducteurs de type différent et aussi des circuits avec des fonctionnalités différentes sur un même substrat.

Pour cela, la présente invention propose un dispositif à MOSFET sur SOI, comprenant :

- une région supérieure comportant au moins un premier dispositif semi-conducteur de type MOSFET disposé sur une première couche de semi-conducteur empilée sur une première couche isolante, une première portion d'une première couche métallique et une première portion d'une seconde couche de semi-conducteur ;

- une région inférieure comportant au moins un second dispositif semi-conducteur de type MOSFET

disposé sur une seconde portion de la seconde couche de semi-conducteur, une grille du second dispositif semi-conducteur étant formée par au moins une seconde portion de la première couche métallique.

5 la seconde couche de semi-conducteur étant disposée sur une seconde couche isolante empilée sur une seconde couche métallique.

La première couche de semi-conducteur et la première couche isolante forment un substrat SOI pour  
10 le premier dispositif semi-conducteur, la seconde portion de la seconde couche de semi-conducteur et la seconde couche isolante formant un autre substrat SOI pour le second dispositif semi-conducteur.

Ainsi, chacun des dispositifs  
15 semi-conducteurs est réalisé sur un substrat SOI différent, permettant à chaque dispositif et chaque substrat d'avoir ses propres caractéristiques. Les dispositifs semi-conducteurs de type MOSFET sont intégrés sur deux niveaux différents, réalisant une  
20 intégration « en trois dimensions » non empilée, les dispositifs semi-conducteurs n'étant pas superposés l'un au-dessus de l'autre.

L'un des premier ou second dispositif semi-conducteur de type MOSFET peut être un transistor  
25 PMOS et l'autre des premier ou second dispositif semi-conducteur de type MOSFET peut être un transistor NMOS.

Selon l'invention, les deux dispositifs semi-conducteurs ont chacun une commande arrière, ou  
30 « ground plane », formée respectivement par la première portion de la première couche métallique et la seconde

couche métallique, intégrée et contactée complètement indépendamment grâce à une intégration sur deux niveaux. La tension appliquée à l'une et/ou l'autre des deux commandes arrières peut être nulle, ou non si on  
5 veut réaliser un contrôle arrière des dispositifs semi-conducteurs.

La première portion de la première couche métallique peut être de type P lorsque le premier dispositif semi-conducteur est un transistor NMOS, ou  
10 de type N lorsque le premier dispositif semi-conducteur est un transistor PMOS, ou encore de type « midgap », c'est-à-dire dont le travail de sortie soit compris entre environ 4,17 eV et 5,1 eV, ou entre 4,55 eV et 4,65 eV, et la seconde couche métallique peut être de  
15 type P lorsque le second dispositif semi-conducteur est un transistor NMOS ou de type N lorsque le second dispositif semi-conducteur est un transistor PMOS. Cette configuration permet d'empêcher une forte dégradation du DIBL (« Drain Inducted Barrier  
20 Lowering » en anglais, ou abaissement de barrière induit par le drain) du transistor et de la pente sous le seuil, lorsque la longueur de grille diminue.

L'épaisseur de la première couche isolante et/ou de la seconde couche isolante peut être  
25 inférieure ou égale à environ 20 nm. Ainsi, la couche mince isolante d'un substrat SOI (ou BOX pour « Buried Oxide » en anglais, c'est-à-dire oxyde enterré) permet la réalisation d'un dispositif de type MOSFET à déplétion totale (« fully-depleted » en anglais)  
30 pleinement efficace, la commande arrière de ce dispositif limitant l'extension de la zone de charge

d'espace sous le canal et donc contribuant à réduire les effets de canal court, notamment dans le cas d'un canal faiblement dopé ou non dopé, ou lorsque la grille du dispositif MOSFET est à base de métal et/ou est siliciurée. A faible dopage de canal, l'utilisation d'une commande arrière permet de gagner un facteur 2 sur le DIBL du transistor, c'est-à-dire d'avoir un DIBL réduit d'environ 100 mV par rapport au DIBL d'un transistor à faible dopage de canal sans commande arrière.

De préférence, les canaux des dispositifs semi-conducteurs de type MOSFET peuvent être non dopés.

Le dispositif peut comporter au moins une région isolante séparant latéralement ladite région supérieure de ladite région inférieure.

La première et/ou la seconde couche de semi-conducteur peut être à base de silicium, et/ou de silicium contraint, et/ou de silicium-germanium, et/ou de Germanium, et/ou de tout autre matériau de type III-V.

Le semi-conducteur de la première couche de semi-conducteur peut avoir une orientation cristalline différente de celle du semi-conducteur de la seconde couche de semi-conducteur. Par exemple, le semi-conducteur de l'une de la première ou de la seconde couche de semi-conducteur peut avoir une orientation cristalline égale à (100) et le semi-conducteur de l'autre de la première ou de la seconde couche peut avoir une orientation cristalline égale à (110).

La présente invention permet donc :

- de réaliser des transistors NMOS et PMOS sur SOI avec des orientations cristallines différentes adéquates ;

5 - de réaliser des transistors NMOS et PMOS ou un circuit avec des fonctions logiques sur un même niveau et de réaliser d'autres fonctions avec des matériaux différents sur un autre niveau ;

- d'obtenir, en terme de fonctions logiques, des intégrations horizontales et verticales ;

10 - d'obtenir des transistors à multiples tensions de seuil, en jouant sur les épaisseurs des couches isolantes des substrats SOI, sur la nature et le travail de sorti des commandes arrières qui va moduler les tensions de seuil du PMOS et du NMOS.

15 La présente invention concerne également un procédé de réalisation d'un dispositif à MOSFET sur SOI, comprenant au moins les étapes de :

a) réalisation d'une structure formée d'une première couche de semi-conducteur empilée sur une  
20 première couche isolante, une première couche métallique, une seconde couche de semi-conducteur, une seconde couche isolante et une seconde couche métallique ;

b) gravure d'une partie d'au moins la  
25 première couche de semi-conducteur et la première couche isolante, mettant à nu une partie de la première couche métallique et définissant des régions supérieure et inférieure du dispositif à MOSFET sur SOI ;

c) dépôt d'une couche diélectrique et d'un  
30 matériau de grille sur une partie non gravée de la

première couche de semi-conducteur au niveau de la partie supérieure du dispositif à MOSFET sur SOI ;

d) gravure du matériau de grille et de la première couche métallique, formant les grilles d'un premier et d'un second dispositif semi-conducteur de type MOSFET respectivement au niveau des régions supérieure et inférieure ;

e) réalisation des premier et second dispositifs semi-conducteurs de type MOSFET ;

Le procédé peut comporter en outre, après l'étape e), une étape de réalisation d'un premier contact électrique connecté à la première couche métallique et d'un second contact électrique connecté à la seconde couche métallique, les deux contacts électriques pouvant être indépendants l'un de l'autre.

Le procédé peut également comporter en outre, après l'étape e), une étape de réalisation d'une région isolante séparant latéralement la région supérieure de la région inférieure.

Les contacts électriques reliés aux couches métalliques formant les commandes arrières des dispositifs semi-conducteurs sont réalisés après la formation des dispositifs semi-conducteurs, une fois pour tout le circuit ou en utilisant une zone de STI (« Shallow Trench Isolation » en anglais, ou tranches d'isolation de surface) les contacts électriques passant à travers cette zone de STI sans créer de courts-circuits.

Avec ce procédé, il est possible de réaliser des grilles de dispositifs de type MOSFET, par exemples à base de matériaux différents ou non, en

mettant en oeuvre une seule étape de lithographie de grille, contrairement aux procédés de réalisation de dispositifs double grille de l'art antérieur. Les tensions de seuil pourront aussi être ajustées par l'utilisation de la polarisation indépendante des deux régions de commande arrière ou par le dopage ou le travail de sorti de la commande arrière.

Une co-intégration de dispositifs à déplétion partielle et à déplétion totale peut être réalisée sans nécessité d'épitaxie ou d'amincissement des couches semi-conductrices.

Selon le procédé, objet de la présente invention, on réalise une grille pour le second dispositif semi-conducteur de type MOSFET et une commande arrière pour le premier dispositif semi-conducteur de type MOSFET à partir d'une même couche métallique.

#### **BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS**

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés à titre purement indicatif et nullement limitatif en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente un dispositif à MOSFET sur SOI, objet de la présente invention, selon un mode de réalisation particulier,

- les figures 2A à 2F représentent les différentes étapes d'un procédé de réalisation d'un dispositif MOSFET sur SOI, objet de la présente invention, selon un premier mode de réalisation,

- les figures 3A à 3B représentent des étapes d'un procédé de réalisation d'un dispositif MOSFET sur SOI, objet de la présente invention, selon un second mode de réalisation,

5 - la figure 4 représente une étape d'un procédé de réalisation d'un dispositif MOSFET sur SOI, objet de la présente invention, selon un troisième mode de réalisation.

Des parties identiques, similaires ou  
10 équivalentes des différentes figures décrites ci-après portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une  
15 échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

Les différentes possibilités (variantes et modes de réalisation) doivent être comprises comme n'étant pas exclusives les unes des autres et peuvent  
20 se combiner entre elles.

#### **EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS**

On se réfère tout d'abord à la figure 1 qui représente un dispositif à MOSFET sur SOI 1 selon un mode de réalisation particulier.

25 Ce dispositif 1 comporte deux régions 102 et 104 comportant chacune respectivement un dispositif semi-conducteur de type MOSFET.

La région supérieure 102 comporte un transistor 106 de type PMOS formé par une grille 108,  
30 un diélectrique de grille 109, des zones de source et

de drain, respectivement 112, 114 et un canal 116 réalisées dans une couche à base de semi-conducteur 118. Des espaceurs 120 sont également réalisés sur les côtés de la grille 108. La grille 108 est connectée à un contact de grille 122, par lequel une tension de commande est appliquée à la grille 108.

La grille 108 est à base de métal, par exemple à base de molybdène et/ou de tungstène. Dans une variante, la grille pourrait être à base de polysilicium. La couche diélectrique 109 est à base d'un matériau de préférence à forte permittivité, c'est-à-dire de constante diélectrique supérieure ou égale à environ 3,9, tel que par exemple du silicate d'hafnium ou de l'oxyde d'hafnium, et d'une épaisseur par exemple égale à environ 3 nm. La couche de semi-conducteur 118 est par exemple une couche de silicium, d'une épaisseur par exemple égale à environ 10 nm. Une portion 123a d'une couche de polysilicium est ici disposée sur la grille métallique 108, par exemple d'une épaisseur comprise entre environ 50 nm et 100 nm. Dans ce mode de réalisation, la grille 108 est également siliciurée par une couche de siliciure 124 disposée sur la portion de polysilicium 123a, recouvrant également les zones de source et de drain 112, 114, par exemple à base de siliciure de nickel ou siliciure de cobalt, obtenue par dépôt de métal et recuit. Cette couche de siliciure 124 permet d'améliorer le contact avec la grille 108 et les zones de source et drain 112, 114 en diminuant les résistances de contact. La couche 118 est ici à base de silicium d'orientation cristalline (110), permettant

ainsi d'augmenter la mobilité des trous. La couche 118 peut également être à base de silicium contraint, permettant d'augmenter la mobilité des porteurs et donc d'augmenter les performances en courant du transistor.

5                   La couche de silicium 118 repose sur une couche isolante 126, par exemple à base d'oxyde de silicium. Dans ce mode de réalisation, la couche isolante 126 est formée de deux sous-couches 126a, 126b collées entre elles par collage moléculaire.  
10 L'épaisseur de la couche isolante 126 est par exemple d'environ 20 nm. Typiquement, la couche isolante 126 aura une épaisseur inférieure ou égale à environ 20 nm.

Ainsi, la couche de silicium 118 et la  
15 couche isolante 126 forment un substrat SOI pour le PMOS 126. Compte tenu de l'épaisseur de 10 nm de la couche de silicium 118 et de l'épaisseur de 20 nm de la couche isolante 126, le PMOS 106 est donc ici à déplétion totale.

20                   Une portion 128a d'une couche métallique 128, par exemple à base de nitrure de titane et d'une épaisseur égale à environ 10 nm, disposée sous la couche isolante 126, sert de commande arrière au PMOS 106, permettant d'agir sur le potentiel et la déplétion  
25 dans le canal 116, et donc modifiant la tension de seuil du PMOS 106. Cette portion 128a est connectée à un contact métallique 129 par lequel une tension de commande arrière est appliquée à la portion métallique 128a. La couche métallique 128 pourrait également être  
30 réalisée à base de carbure de tantale, ou encore à base de polysilicium.

Enfin, la portion 128a de couche métallique repose sur une portion 130a d'une couche d'oxyde 130, par exemple à base d'un matériau de préférence à forte permittivité, c'est-à-dire de constante diélectrique supérieure à environ 3,9, tel que du silicate d'hafnium ou de l'oxyde d'hafnium et d'une épaisseur égale à environ 3 nm, et sur une portion 132a d'une couche de semi-conducteur 132, par exemple à base silicium, d'une épaisseur égale à environ 10 nm, et d'orientation cristalline (100). Dans une variante de ce mode de réalisation, la couche de semi-conducteur 118 pourrait avoir une orientation cristalline (100) et la couche de semi-conducteur 132 une orientation cristalline (110), augmentant ainsi la mobilité des trous et donc les performance du PMOS 106. Mais les orientations cristallines de ces deux couches 118, 132 à base de semi-conducteur pourraient également être différentes de ces deux exemples d'orientation cristalline.

La région inférieure 104 comporte un transistor 134 de type NMOS. Le NMOS 134 comporte une grille 128b. Cette grille 128b est une autre portion de la couche métallique 128, c'est-à-dire à base de nitrure de titane et d'une épaisseur égale à environ 10 nm. Le NMOS 134 comporte également un diélectrique de grille formé en partie par une autre portion 130b de la couche diélectrique 130, des zones de source et de drain, respectivement 136 et 138, et un canal 140 réalisées dans une autre portion 132b de la couche de silicium 132. Etant donné que la couche de silicium 132 est à base de silicium d'orientation cristalline (100),

on augmente la mobilité des électrons et améliore donc les performances en courant du transistor NMOS 134.

Des espaceurs 142 sont également réalisés sur les côtés de la grille 128b, ainsi que des  
5 espaceurs 154 permettant d'isoler les couches à base de semi-conducteur.

La grille 128b est connectée à un contact de grille 144, acheminant la tension de commande à la grille 144. Dans ce mode de réalisation, la grille 128b  
10 est également recouverte d'une portion 123b d'une couche de polysilicium et siliciurée par une couche de siliciure 145, recouvrant également les zones de source et de drain 136, 138, par exemple à base de siliciure de nickel ou siliciure de cobalt, obtenue par dépôt de  
15 métal et recuit. Cette couche de siliciure 145 permet d'améliorer le contact avec la grille 128b et les zones de source et drain 136, 138 en diminuant les résistances de contact. Dans une variante, la grille du NMOS 104 peut également comporter, outre la portion  
20 128b de la couche métallique 128, une portion du matériau formant la grille 108 disposée entre la portion 128b de la couche métallique 128 et la portion de polysilicium 123b.

Les régions inférieure 104 et supérieure  
25 102 sont disposées sur une couche isolante 146, par exemple à base d'oxyde de silicium et d'une épaisseur inférieure ou égale à environ 20 nm.

Ainsi, la portion 132b de la couche de silicium 132 et la couche isolante 146 forment un  
30 substrat SOI pour le NMOS 134. De part les épaisseurs de la couche de silicium 132 et de la couche isolante

146, le NMOS 134 forme ici un transistor à déplétion totale, permettant de mieux contrôler les effets de canal court. De plus, le canal 140 du NMOS est ici non dopé, ce qui permet de travailler à un champ effectif plus faible et donc d'avoir une mobilité non dégradée par un dopage de canal, augmentant ainsi les performances des dispositifs.

La couche isolante 146 est disposée sur une couche métallique 148, par exemple à base de nitrure de titane et d'une épaisseur égale à environ 10 nm, elle-même disposée sur un substrat 150 à base de semi-conducteur tel que du silicium. Cette couche métallique 148 est connectée à un contact 152 permettant de réaliser une commande arrière du NMOS 134.

Les contacts électriques de commandes arrières 129 et 152 sont indépendants l'un de l'autre, la commande arrière étant donc indépendante pour le PMOS 106 et le NMOS 134.

Enfin, une couche d'oxyde 153 est déposée sur l'ensemble du dispositif 1, réalisant une isolation globale des couches formant le dispositif 1.

Un procédé de réalisation du dispositif à MOSFET sur SOI 1 selon un premier mode de réalisation va maintenant être décrit en liaison avec les figures 2A à 2F.

Comme représenté sur la figure 2A, on réalise tout d'abord une structure comportant le substrat 150 à base de semi-conducteur sur laquelle est empilée la couche métallique 148, la couche isolante 146 et la couche de silicium 132 d'orientation cristalline (100).

On réalise ensuite dans la couche de silicium 132 des zones 149 de silicium-germanium. Ces zones 149 sont créées par photolithographie, puis par implantation de germanium dans la seconde couche de silicium 132 aux emplacements de ces zones 149. Un recuit transforme ensuite le silicium dans lequel est implanté le germanium en silicium-germanium, formant les zones 149. Sur la figure 2B, la couche de silicium 132 ainsi divisée en deux portions 132a et 132b, les zones 149 de silicium-germanium séparant les portions 132a, 132b de silicium. De manière générale, les zones 149 peuvent également être réalisées à partir d'au moins un matériau pouvant être retiré sélectivement par rapport au matériau de la couche 132, tel que du bore, du phosphore, de l'aluminium, ou oxyde, par exemple en réalisant un dopage en phase vapeur (VPD ou « Vapor Phase Doping » en anglais) pour former les zones 149.

Comme représenté sur la figure 2C, on dépose ensuite, sur la couche de silicium 132, la couche diélectrique 130, sur laquelle est déposée la couche métallique 128 et la sous-couche isolante 126a.

On réalise ensuite un collage moléculaire entre la première structure précédemment réalisée et une seconde structure formée d'un empilement double SOI comportant une première sous-couche isolante 126b, par exemple d'une épaisseur égale à environ 10 nm, de la couche de silicium 118, d'une couche isolante 156, par exemple à base d'oxyde de silicium et d'une épaisseur égale à environ 145 nm, et une autre couche de silicium 158, par exemple similaire à la couche de silicium 150. Le collage moléculaire est réalisé entre les deux sous-

couches 126a, 126b formant ainsi une couche isolante 126 d'épaisseur égale à environ 20 nm.

Comme représenté sur la figure 2E, on retire la couche de silicium 158 et la couche d'oxyde 156, puis on réalise une photolithographie et une gravure pour définir les zones actives sur lesquelles seront réalisés les transistors NMOS et PMOS. La gravure est stoppée au niveau de la couche métallique 128. Ainsi, on définit les régions supérieure 102 et inférieure 104 du dispositif 1.

On réalise ensuite le dépôt de la couche de diélectrique 109, de métal ou de polysilicium pour la réalisation de la grille 108 et d'une couche de polysilicium pour former les portions 123a et 123b disposées sur les grilles 108 et 128b. Une photolithographie et une gravure du métal 108 et de la couche métallique, 128 ainsi que des couches diélectriques 109 et 130 et de la couche de polysilicium permettront de former la grille métallique 108 pour la réalisation du PMOS 106 et la grille métallique 128b du NMOS 134 (figure 2F). Dans une variante, il est possible de conserver une portion de la couche diélectrique 109 sur la grille métallique 128b. Les matériaux des grilles 128b et 108 peuvent être de même nature ou de nature différentes, formant alors des grilles duales permettant d'ajuster la tension de seuil pour le NMOS 134 et le PMOS 106.

On réalise alors les zones de sources 112, 136 et de drain 114, 138 dans le silicium 118 et 132b. On retire ensuite, de manière sélective par rapport au silicium de la couche 132, les zones 149 de silicium-

germanium. Une épitaxie supplémentaire peut également être réalisée afin de surélever les zones de source 112, 136 et de drain 114, 138, facilitant la formation ultérieure de couches de siliciure 124 et 145 sur ces zones de source et de drain. On réalise ensuite les espaceurs 120, 142 et 154, isolant les grilles et les régions supérieure 102 et inférieure 104, et on forme une couche de siliciure 124 et 145 sur les portions de polysilicium 123a et 123b, ainsi que sur les zones de source et de drain. La couche d'oxyde 153 est alors déposée sur l'ensemble du dispositif 1. Enfin, les contacts 129, 122, 144 et 152, venant se connecter aux grilles 108 et 128b et aux commandes arrières formées par la portion 128a de couche métalliques pour le PMOS 106 et par la couche métallique 148 pour le NMOS 134, sont réalisés par une gravure dans la couche d'oxyde, dépôt dans ces gravures d'une barrière d'isolation, par exemple à base de nitrure de titane et/ou de nitrure de tantale, puis par un dépôt d'un métal tel que du tungstène dans les gravures réalisées (voir figure 1).

Un procédé de réalisation du dispositif à MOSFET sur SOI 1 selon un second mode de réalisation va maintenant être partiellement décrit en liaison avec les figures 3A et 3B.

Comme représenté sur la figure 3A on réalise tout d'abord un empilement de couches comportant les mêmes couches que l'empilement représenté sur la figure 2D. Par rapport à la couche de silicium 132 de la figure 2D, la couche de silicium 132 représentée sur la figure 3A ne comporte pas les zones de silicium-germanium 149. Cet empilement de couches

peut par exemple être réalisé par des techniques similaires à celles utilisées pour la réalisation de l'empilement représenté sur la figure 2D.

On retire tout d'abord les couches 158 et  
5 156, puis on réalise ensuite une photolithographie et une gravure de l'ensemble des couches 118, 126, 128, 130 et 132 en s'arrêtant à la couche isolante 146, en séparant ces couches en portions formant les futures régions supérieures 102 et inférieure 104 (figure 3B).

10 Ensuite, on retire le silicium 118 et la partie de la couche isolante 126 se trouvant au niveau de la région inférieure 104. On vient ensuite déposer le diélectrique 109 puis le métal 108 de la grille du PMOS 106. On vient alors réaliser la gravure de la  
15 grille 108. Le procédé est ensuite terminé comme précédemment pour le premier mode de réalisation comme représenté sur la figure 2F, et aboutissant au dispositif 1 de la figure 1.

Un procédé de réalisation d'un dispositif à  
20 MOSFET sur SOI 1 selon un troisième mode de réalisation va maintenant être partiellement décrit en liaison avec la figure 4.

On réalise tout d'abord un empilement de couches comportant les mêmes couches que l'empilement  
25 représenté sur la figure 3A. Cet empilement de couches peut par exemple être réalisé par des techniques similaires à celles utilisées pour la réalisation des empilements représentés sur les figures 2D et 3A.

On retire ensuite les couches 158 et 156,  
30 puis on réalise ensuite une photolithographie et une gravure de l'ensemble des couches 118, 126, 128, 130 et

132 en s'arrêtant à la couche isolante 146, en séparant ces couches en portions formant les futures régions supérieures 102 et inférieure 104, de manière similaire à la figure 3B.

5 On retire ensuite les portions des couches semi-conductrice 118 et isolante 126 au niveau de la région inférieure 104. On dépose alors la couche diélectrique 109 sur la portion restante de la couche 118 se trouvant au niveau de la portion supérieure 106  
10 et sur la portion 128b de la première couche métallique 128, puis une couche de métal 160 et une couche de polysilicium 162 sur l'ensemble de la structure (figure 4).

Enfin, on réalise une gravure de la couche  
15 de polysilicium 162 et de la couche métallique 160 telle qu'il ne reste qu'une portion des couches métalliques 160 et de polysilicium 162 au niveau d'une partie de la couche diélectrique 109 présente au niveau des zones inférieure 104 et supérieure 106. Le  
20 dispositif 1 est ensuite achevé de manière similaire au dispositif aux modes de réalisation décrits précédemment.

La présente invention s'applique à tous les  
nœuds technologiques de réalisation de dispositifs  
25 semi-conducteurs, et particulièrement aux nœuds technologiques inférieur à 100 nm.

**REVENDICATIONS**

1. Dispositif (1) à MOSFET (106, 134) sur SOI, comprenant :

5                   - une région supérieure (102) comportant au moins un premier dispositif semi-conducteur (106) de type MOSFET disposé sur une première couche de semi-conducteur (118) empilée sur une première couche isolante (126), une première portion (128a) d'une  
10 première couche métallique (128) et une première portion (132a) d'une seconde couche de semi-conducteur (132) ;

                  - une région inférieure (104) comportant au moins un second dispositif semi-conducteur (134) de  
15 type MOSFET disposé sur une seconde portion (132b) de la seconde couche de semi-conducteur (132), une grille (128b) du second dispositif semi-conducteur (134) étant formée par au moins une seconde portion (128b) de la première couche métallique (128) ;

20                   la seconde couche de semi-conducteur (132) étant disposée sur une seconde couche isolante (146) empilée sur une seconde couche métallique (148).

2. Dispositif (1) selon la revendication  
25 1, la première (118) et/ou la seconde (132) couche de semi-conducteur étant à base de silicium contraint.

3. Dispositif (1) selon l'une des revendications précédentes, le semi-conducteur de la  
30 première couche (118) ayant une orientation cristalline

différente de celle du semi-conducteur de la seconde couche (132).

4. Dispositif (1) selon l'une des  
5 revendications précédentes, le semi-conducteur de l'une  
de la première (118) ou de la seconde couche (132) de  
semi-conducteur ayant une orientation cristalline égale  
à (100) et le semi-conducteur de l'autre de la première  
(118) ou de la seconde couche (132) ayant une  
10 orientation cristalline égale à (110).

5. Dispositif (1) selon l'une des  
revendications précédentes, l'un des premier (106) ou  
second (134) dispositif semi-conducteur de type MOSFET  
15 étant un transistor PMOS et l'autre des premier (106)  
ou second (134) dispositif semi-conducteur de type  
MOSFET étant un transistor NMOS.

6. Dispositif (1) selon la revendication  
20 5, la première portion (128a) de la première couche  
métallique (128) étant de type P lorsque le premier  
dispositif semi-conducteur (106) est un transistor  
NMOS, ou de type N lorsque le premier dispositif semi-  
conducteur (106) est un transistor PMOS, ou de type  
25 midgap.

7. Dispositif (1) selon l'une des  
revendications 5 ou 6, la seconde couche métallique  
(148) étant de type P lorsque le second dispositif  
30 semi-conducteur (134) est un transistor NMOS ou de type

N lorsque le second dispositif semi-conducteur (134) est un transistor PMOS.

5 8. Dispositif (1) selon l'une des revendications précédentes, une grille (108) du premier dispositif semi-conducteur (106) étant à base d'un matériau différent du métal de la seconde couche métallique (148).

10 9. Dispositif (1) selon l'une des revendications précédentes, la première portion (128a) de la première couche métallique (128) étant connectée à un premier contact électrique (129), la seconde couche métallique (148) étant connectée à un second contact  
15 électrique (152) indépendant du premier contact électrique (129).

20 10. Dispositif (1) selon l'une des revendications précédentes, comportant en outre au moins une région isolante (154) séparant latéralement ladite région supérieure (102) de ladite région inférieure (104).

25 11. Dispositif (1) selon l'une des revendications précédentes, l'épaisseur de la première couche isolante (126) et/ou de la seconde couche isolante (146) étant inférieure ou égale à environ 20 nm.

12. Procédé de réalisation d'un dispositif (1) à MOSFET (106, 134) sur SOI, comprenant au moins les étapes de :

- 5 a) réalisation d'une structure formée d'une première couche de semi-conducteur (118) empilée sur une première couche isolante (126), une première couche métallique (128), une seconde couche de semi-conducteur (130), une seconde couche isolante (146) et une seconde couche métallique (148) ;
- 10 b) gravure d'une partie d'au moins la première couche de semi-conducteur (118) et la première couche isolante (126), mettant à nu une partie de la première couche métallique (128) et définissant des régions supérieure (102) et inférieure (104) du
- 15 dispositif (1) à MOSFET sur SOI ;
- c) dépôt d'une couche diélectrique (109) et d'un matériau de grille (108) sur une partie non gravée de la première couche de semi-conducteur (118) au niveau de la partie supérieure (102) du dispositif (1)
- 20 à MOSFET sur SOI ;
- d) gravure du matériau de grille (108) et de la première couche métallique (128), formant les grilles (108, 128b) d'un premier (106) et d'un second (134) dispositif semi-conducteur de type MOSFET
- 25 respectivement au niveau des régions supérieure (102) et inférieure (104) ;
- e) réalisation des premier (106) et second (134) dispositifs semi-conducteur de type MOSFET.

30 13. Procédé selon la revendication 12, comportant en outre, après l'étape e), une étape de

réalisation d'un premier contact électrique (129) connecté à la première couche métallique (128) et d'un second contact électrique (152) connecté à la seconde couche métallique (148), les deux contacts électriques (129, 152) étant indépendants l'un de l'autre ;

14. Procédé selon l'une des revendications 12 ou 13, comportant en outre, après l'étape e), une étape de réalisation d'au moins une région isolante (154) séparant latéralement la région supérieure (102) de la région inférieure (104).

15. Procédé selon l'une des revendications 12 à 14, la réalisation de l'étape a) comportant la formation, par implantation d'ions et cuisson, dans la seconde couche à base de semi-conducteur (132), de zones (149) définissant les portions (132a, 132b) de la seconde couche de semi-conducteur (132) et pouvant être gravées sélectivement par rapport au semi-conducteur de ladite seconde couche (132), et comportant en outre, après l'étape d), une étape de gravure sélective de ces zones (149).

16. Procédé selon l'une des revendications 12 à 14, la mise en œuvre de l'étape b) comportant également la gravure de la première couche métallique (128) et de la seconde couche de semi-conducteur (132).

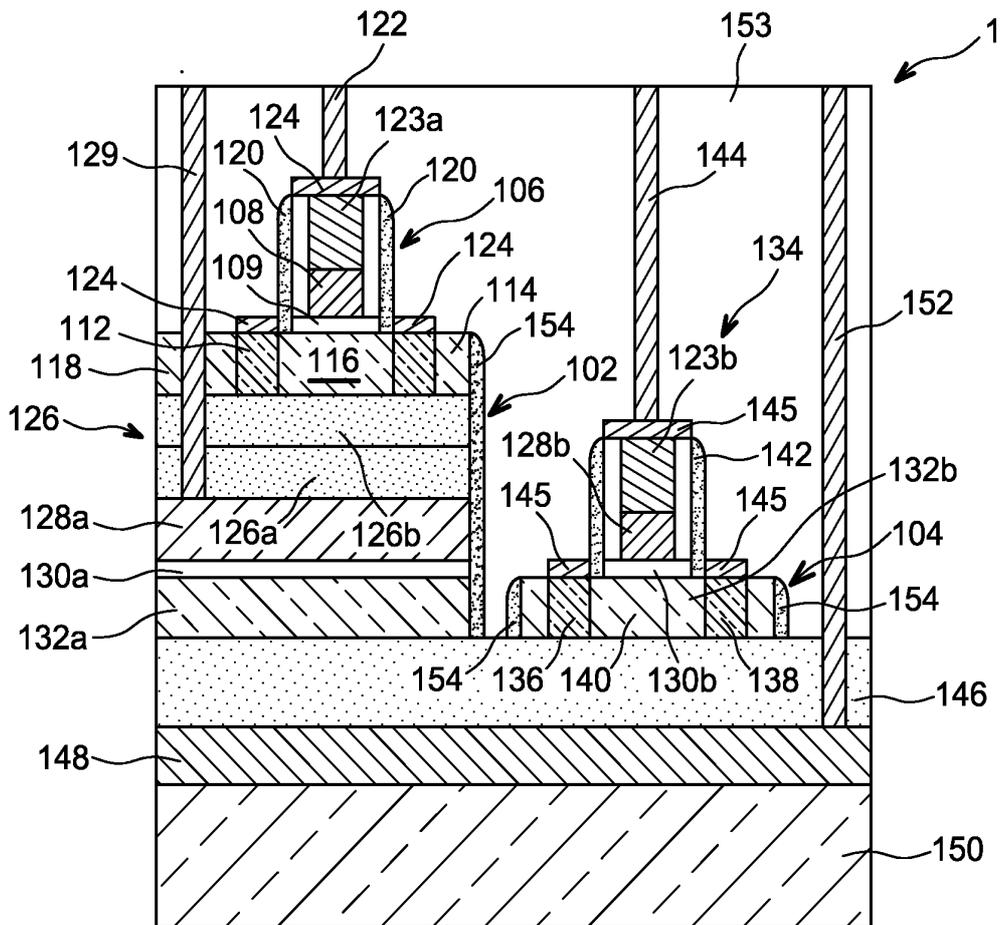


FIG. 1

2 / 6

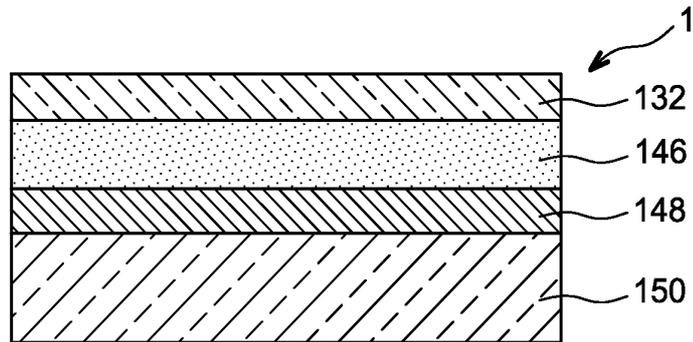


FIG. 2A

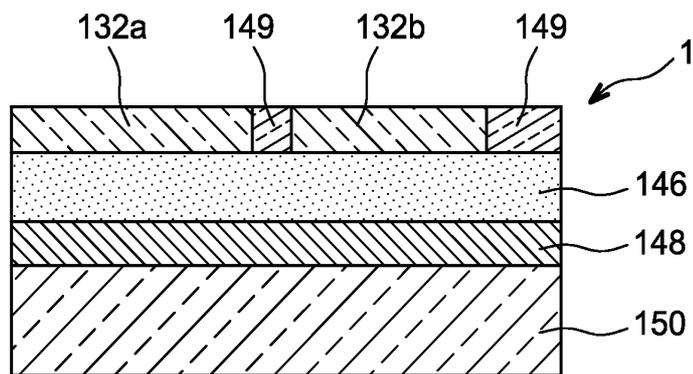


FIG. 2B

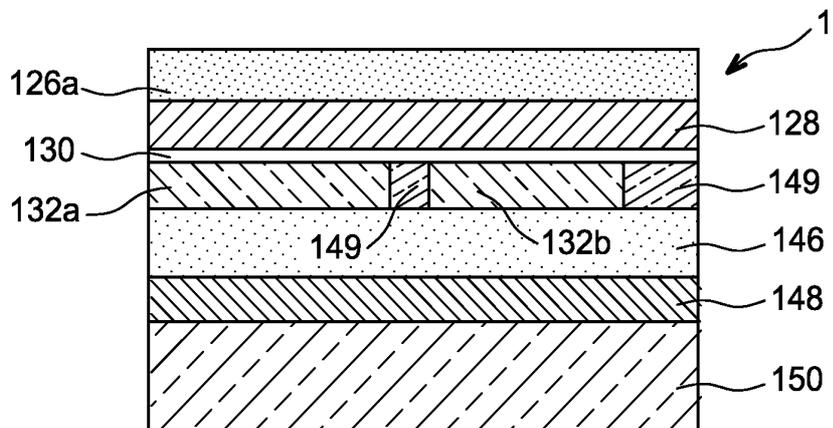


FIG. 2C

3 / 6

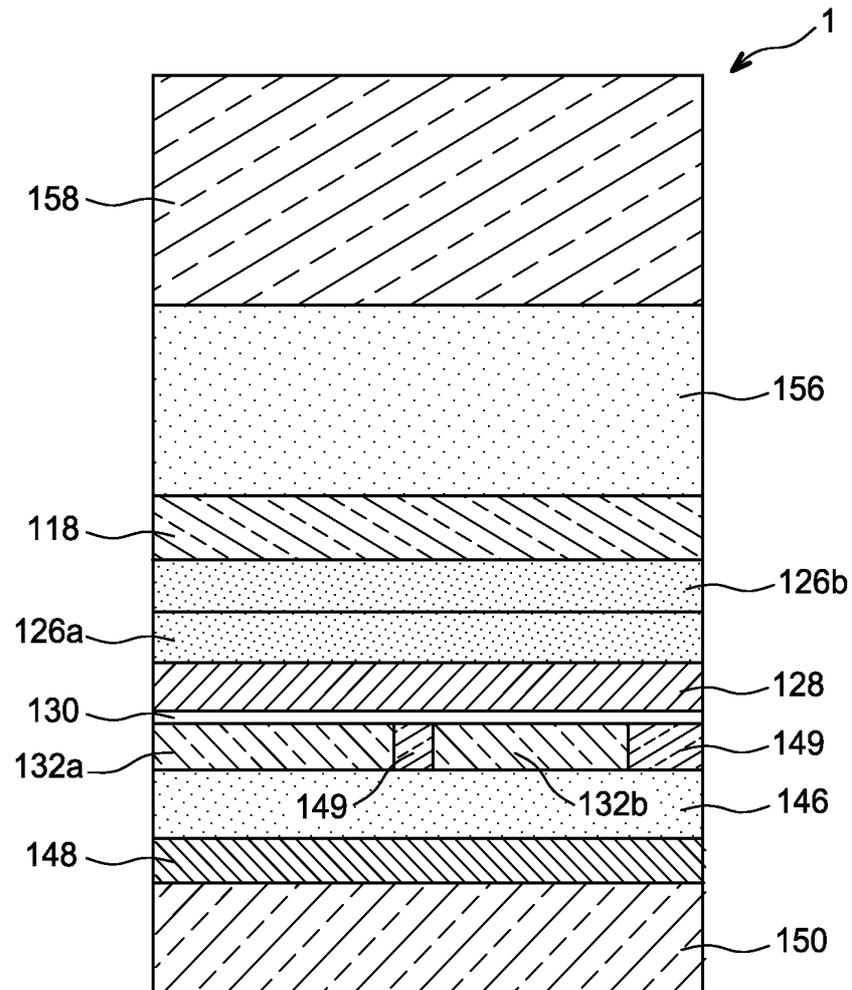


FIG. 2D

4 / 6

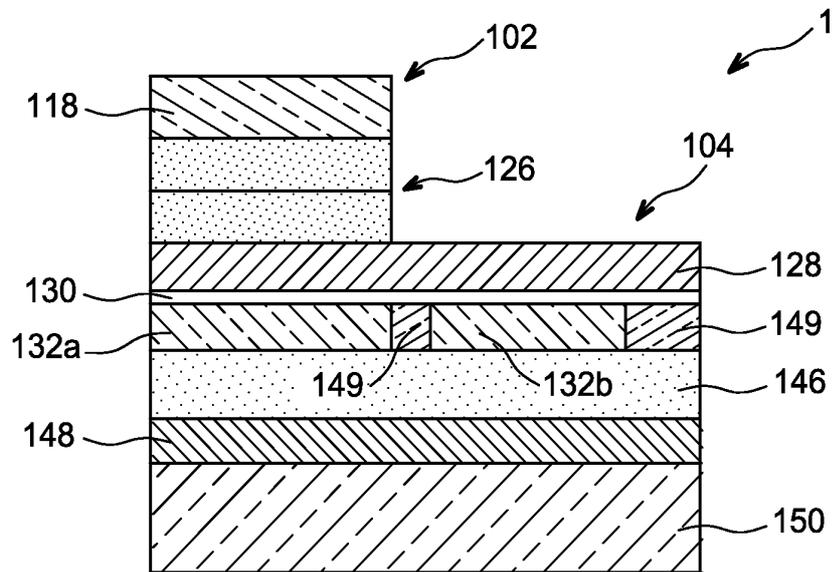


FIG. 2E

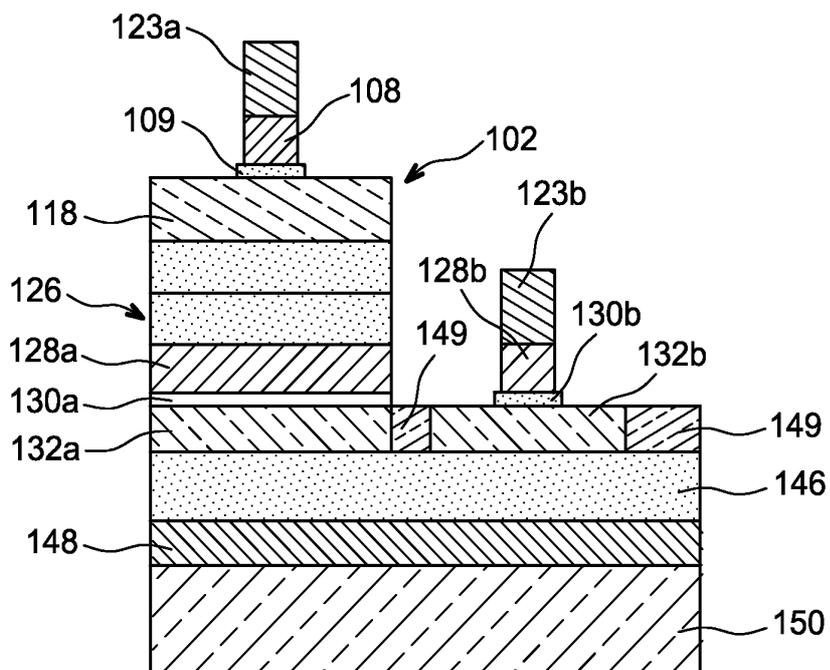


FIG. 2F

5 / 6

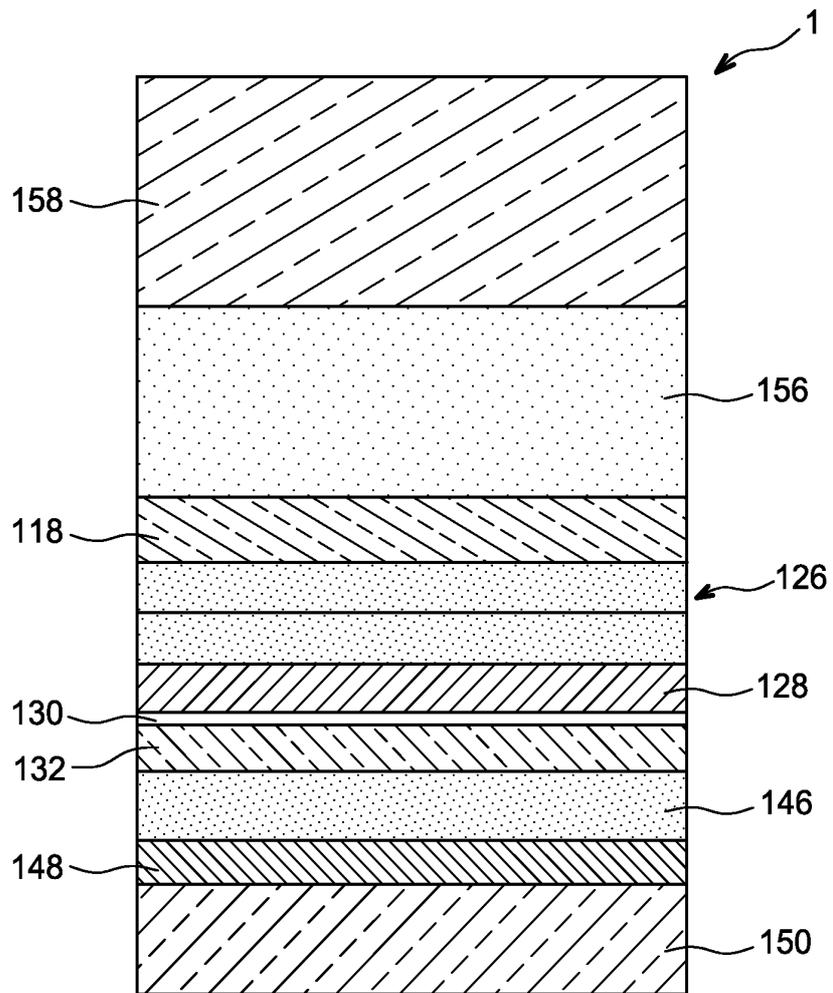


FIG. 3A

6 / 6

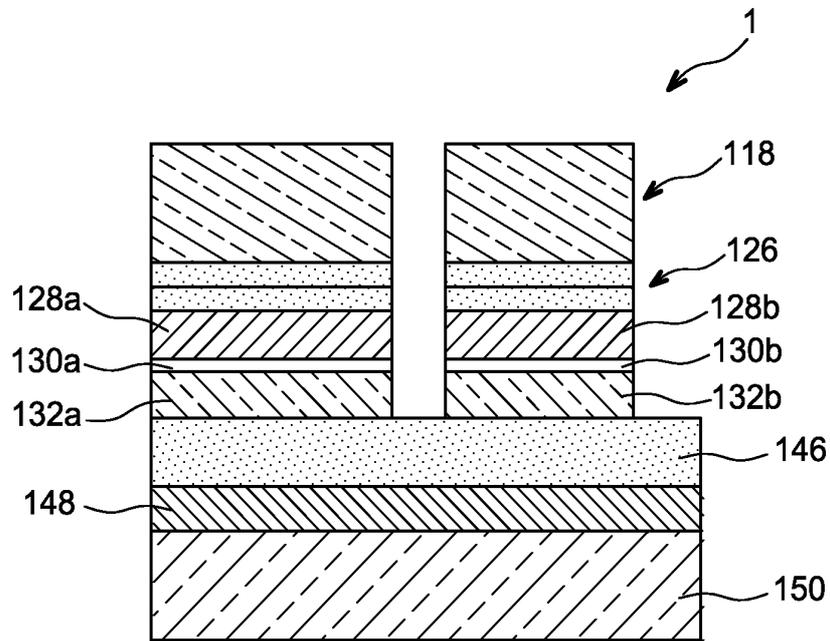


FIG. 3B

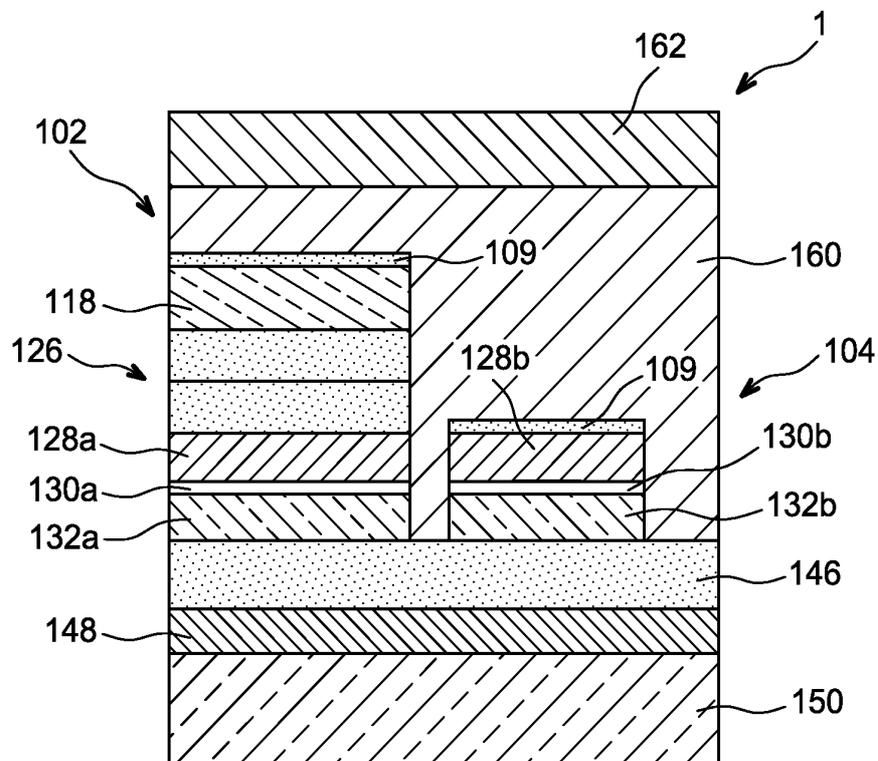


FIG. 4



**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRÉLIMINAIRE**

N° d'enregistrement national

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FA 689781  
FR 0752776

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	US 2005/082531 A1 (RIM KERN [US]) 21 avril 2005 (2005-04-21) * page 2, alinéa 30 - page 4, alinéa 55 * * figures 3E,4E *	1-11	H01L21/84 H01L27/12
A	-----	12-16	
Y	US 7 102 166 B1 (BRYANT ANDRES [US] ET AL) 5 septembre 2006 (2006-09-05) * colonne 3, ligne 11-67 * * figure 8 *	1-11	
A	-----	12-16	
A	US 2002/063286 A1 (WU DE-YUAN [TW] ET AL) 30 mai 2002 (2002-05-30) * page 2, alinéa 18 * * page 3, alinéa 27 * * figure 8 *	1-16	
D,A	ISABEL Y YANG ET AL: "Back-Gated CMOS on SOIAS For Dynamic Threshold Voltage Control" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE SERVICE CENTER, PISACATAWAY, NJ, US, vol. 44, no. 5, mai 1997 (1997-05), XP011016162 ISSN: 0018-9383 * page 824, colonne de droite, alinéa 2 * * figure 6 *	1-16	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) H01L
		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
		8 octobre 2007	Ekoué, Adamah
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14) 2

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0752776 FA 689781**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **08-10-2007**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2005082531 A1	21-04-2005	US 2006125013 A1	15-06-2006
US 7102166 B1	05-09-2006	AUCUN	
US 2002063286 A1	30-05-2002	AUCUN	